

**10-034**

**Obtenção de filmes finos orientados de LaNiO<sub>3</sub> como candidato a eletrodo oxido para capacitores de Pb<sub>1-(x+y)</sub>CaxSryTiO<sub>3</sub>**

Pontes, D.S.L.(1); Pontes, F.M.(1); Longo, E.(2); Galhiane, M.S(1); Santos, L.S(1)  
(1) UNESP-FC; (2) UNESP-IQ

Filmes finos de eletrodos óxidos cerâmicos de LaNiO<sub>3</sub> foram depositados sobre substratos monocristalinos de SrTiO<sub>3</sub> (100) e LaAlO<sub>3</sub> (100) pela técnica spin-coating. O filme foi tratado termicamente a 700°C/2 horas em atmosfera de O<sub>2</sub>. O eletrodo óxido cerâmico de LaNiO<sub>3</sub> cresceu na direção dos planos cristalográficos preferenciais da família h00 do substrato. Foram realizadas análises preliminares da resistividade versus a temperatura para explorar as medidas elétricas no LaNiO<sub>3</sub>, as medidas foram feitas utilizando o método Van der Pauw. Os valores obtidos da resistividade para o sistema SrTiO<sub>3</sub>(100)/LaNiO<sub>3</sub> variou de  $\sim 7,05 \times 10^{-5}$  Ohms.cm (70,5 micro Ohms.cm) para  $\sim 2,03 \times 10^{-4}$  Ohms.cm (203 micro Ohms.cm) a 10 K e 300 K, respectivamente. Esses valores são muito baixos e indicam que os filmes finos de LNO preparados por rota química e orientados são excelentes candidatos para aplicações prática, destacando o seu uso como eletrodo.